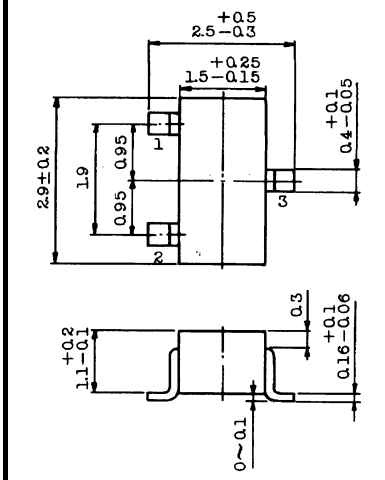
東芝トランジスタ　シリコンNPNエピタキシャル形 (PCT方式)

2SC3265

○ 低周波電力増幅用
○ 電力スイッチング用

- 直流電流増幅率が高い。: h_{FE} (1) = 100~320
- コレクタ･エミッタ間飽和電圧が低い。
  : V_{CE} (sat) = 0.4 V (最大) (I_C = 500 mA, I_B = 20 mA)
- 小型モータのドライブ用に適します。
- 2SA1298 とコンプリメンタリになります。

単位: mm



1. ベース
2. エミッタ
3. コレクタ

S-MINI

JEDEC	TO-236MOD
JEITA	SC-59
東　芝	2-3F1A

質量: 0.012 g (標準)

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項　　目	記　号	定　　格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	25	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	800	mA
ベース電流	I_B	160	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	−55~150	°C

注:　本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。
弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

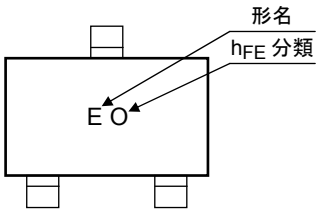
製品量産開始時期
1982-10

電気的特性 (Ta = 25°C)

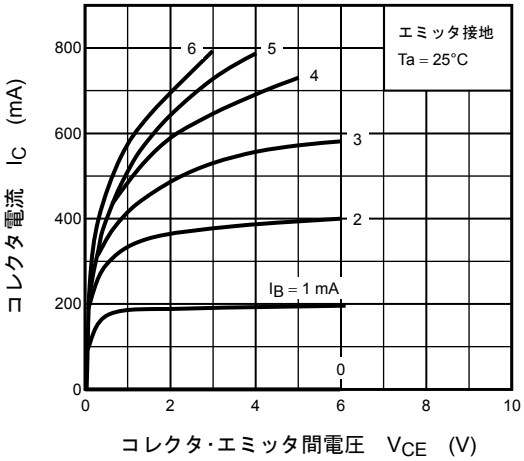
項　　目	記　号	測　定　条　件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB} = 30 V, I_E = 0	—	—	0.1	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB} = 5 V, I_C = 0	—	—	0.1	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)\ CEO}$	I_C = 10 mA, I_B = 0	25	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)\ EBO}$	I_E = 0.1 mA, I_C = 0	5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE\ (1)}$ (注)	V_{CE} = 1 V, I_C = 100 mA	100	—	320	—
	$h_{FE\ (2)}$	V_{CE} = 1 V, I_C = 800 mA	40	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ (sat)}$	I_C = 500 mA, I_B = 20 mA	—	—	0.4	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	V_{CE} = 1 V, I_C = 10 mA	0.5	—	0.8	V
トランジション周波数	f_T	V_{CE} = 5 V, I_C = 10 mA	—	120	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB} = 10 V, I_E = 0, f = 1 MHz	—	13	—	pF

注:　$h_{FE\ (1)}$ 分類　　O: 100~200, Y: 160~320

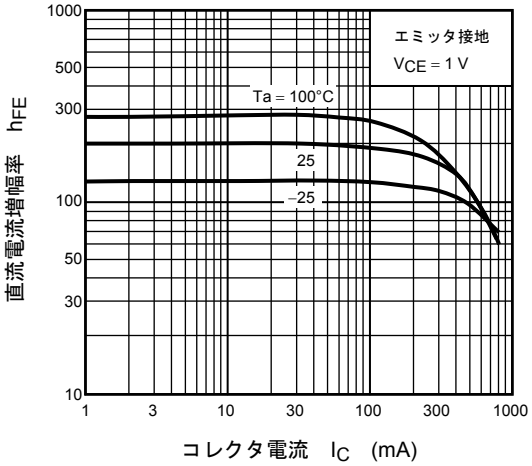
現品表示



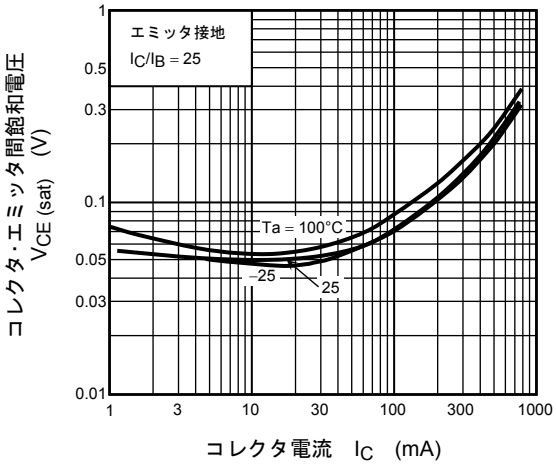
$I_C - V_{CE}$



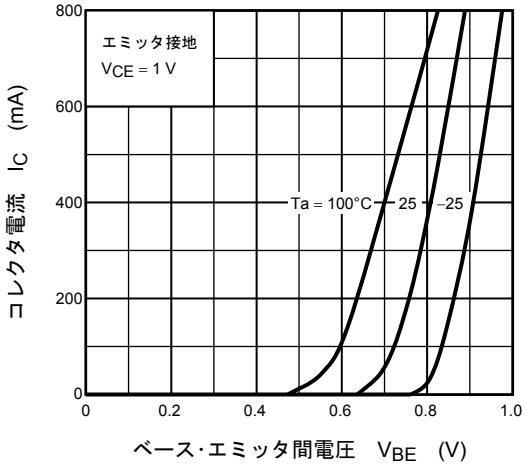
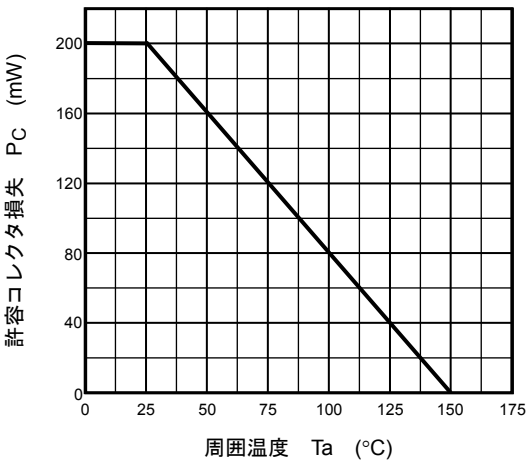
$h_{FE} - I_C$



$V_{CE\,(sat)} - I_C$



$I_C - V_{BE}$



$P_C - Ta$